



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 26072—2010

---

## 太阳能电池用锗单晶

Germanium single crystal for solar cell

2011-01-10 发布

2011-10-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
太 阳 能 电 池 用 锗 单 晶

GB/T 26072—2010

\*

中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行  
北 京 复 兴 门 外 三 里 河 北 街 16 号

邮 政 编 码 : 100045

网 址 : [www.gb168.cn](http://www.gb168.cn)

服 务 热 线 : 010-68522006

2011 年 7 月 第 一 版

\*

书 号 : 155066 · 1-42615

版 权 专 有 侵 权 必 究

## 前 言

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会(SAC/TC 203/SC 2)归口。

本标准由云南临沧鑫圆锗业股份有限公司负责起草。

本标准由南京中锗科技股份有限公司、云南中科鑫圆晶体材料有限公司、北京国晶辉红外光学科技有限公司、厦门乾照光电有限公司参加起草。

本标准主要起草人:惠峰、普世坤、包文东、郑洪、张莉萍、孙小华、苏小平、王向武。

# 太阳能电池用锗单晶

## 1 范围

本标准规定了太阳能电池用锗单晶棒的术语、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单内容。

本标准适用于垂直梯度凝固法(VGF)和直拉法(CZ)制备的太阳能电池用锗单晶滚圆棒。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 1550 非本征半导体材料导电类型测试方法
- GB/T 1555 半导体单晶晶向测定方法
- GB/T 4326 非本征半导体单晶 霍尔迁移率和霍尔系数测量方法
- GB/T 5252 锗单晶位错腐蚀坑密度测量方法
- GB/T 14264 半导体材料术语
- GB/T 14844 半导体材料牌号表示方法
- GB/T 26074 锗单晶电阻率直流四探针测量方法

## 3 术语

GB/T 14264 界定的术语和定义适用于本文件。

## 4 要求

### 4.1 分类

锗单晶棒按导电类型分为 n 型和 p 型两种类型。

### 4.2 牌号

锗单晶棒的牌号表示按 GB/T 14844 的规定。

### 4.3 外形尺寸

锗单晶棒的外形尺寸应符合表 1 的规定,如客户对外形尺寸有特殊要求,供需双方另行商定。

表 1

单位为毫米

直径	$\phi 76.2$	$\phi 100$
直径及偏差	$76.2 \pm 0.2$	$100 \pm 0.2$
长度	$\geq 50$	$\geq 50$